

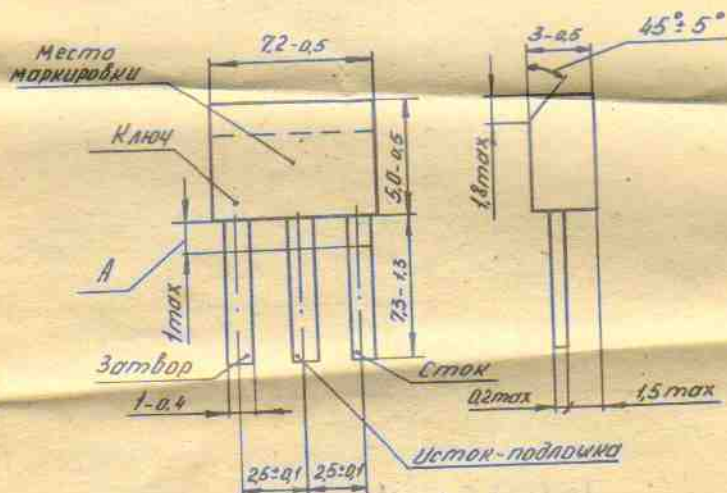


ТРАНЗИСТОРЫ КПЗ1ЗА  
КПЗ1ЗБ, КПЗ1ЗВ

ЭТИКЕТКА

Кремниевые полевые высокочастотные транзисторы КПЗ1ЗА, КПЗ1ЗБ, КПЗ1ЗВ с изолированным затвором и каналом n-типа в пластмассовом корпусе, предназначенные для работы в каскадах генерирования и усиления электрических сигналов высокой частоты.

Вид климатического исполнения УХЛЗ.



В зоне А размеры выводов не регламентированы  
Масса не более 1 г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

( при  $t_{окр.ср.} = ( 25 \pm 10 ) ^\circ\text{C}$  )

Наименование параметра, единица измерения, ( режим измерения )	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Напряжение затвор-исток, В, ( $U_{си} = 10 \text{ В}$ , $I_c = 5 \text{ мА}$ ) КПЗ1ЗА КПЗ1ЗБ КПЗ1ЗВ	$U_{зи}$	0 -1,5 -2,2	2,2 1,5 0
Крутизна характеристики, мА/В, ( $U_{си} = 10 \text{ В}$ , $I_c = 5 \text{ мА}$ , $f = 1000 \text{ Гц}$ )	$S$	4,5	10,5
Напряжение отсечки, В ( $U_{си} = 10 \text{ В}$ , $I_c = 0,01 \text{ мА}$ )	$U_{зи \text{ отс.}}$	-6,0	
Ток утечки затвора, нА, ( $U_{си} = 0$ , $U_{зи} = 10 \text{ В}$ )	$I_{з.ут.}$		8
Входная емкость, пФ, ( $U_{си} = 10 \text{ В}$ , $I_c = 5 \text{ мА}$ )	$C_{IIз}$		7,0
Проходная емкость, пФ ( $U_{си} = 10 \text{ В}$ , $I_c = 5 \text{ мА}$ )	$C_{I2з}$		0,9

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 ШТ. ТРАНЗИСТОРОВ:

Серебро

1,60061

Сплав ПСрОС-3-58

г

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТСЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КПЗ1ЗА, КПЗ1ЗБ, КПЗ1ЗВ соответствуют техническим условиям 0.336.118 ТУ.

Штамп ОТК



Штамп Государственной приемки

Перепроверка произведена

дата

Штамп ОТК

Штамп Государственной приемки

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Допускается применение транзисторов, изготовленных в обычном климатическом исполнении в аппаратуре, предназначенной для эксплуатации во всех климатических условиях, при покрытии транзисторов непосредственно в аппаратуре лаками в 3...4 слоя с последующей сушкой в соответствии с РМ II 070.046-82.

2. Пайку выводов допускается производить на расстоянии не ближе 3 мм от корпуса транзистора, радиус закругления не менее 1,5 мм.

Пайку выводов следует производить паяльником мощностью не более 60 Вт в течение не более 3 с, температура пайки не должна превышать  $( 235 \pm 5 ) ^\circ\text{C}$ , при пайке жало паяльника должно быть заземлено.

Разрешается производить пайку путем погружения выводов не более, чем на 3 с в расплавленный припой с температурой не более  $( 260 \pm 5 ) ^\circ\text{C}$ .

Перед погружением в припой выводы промывают спиртом, а затем смачивают флюсом.

При пайке обязательно применение мер защиты корпуса транзистора от попадания флюса и припоя.

3. При эксплуатации транзисторов в условиях механических воздействий их необходимо крепить за корпус.

4. При хранении, транспортировке и эксплуатации обязательно выводы должны быть закорочены между собой до момента установки в аппаратуру.

Допустимое значение статического потенциала 30 В.

5. Не допускается эксплуатация транзисторов в предельных электрических и температурных режимах.